

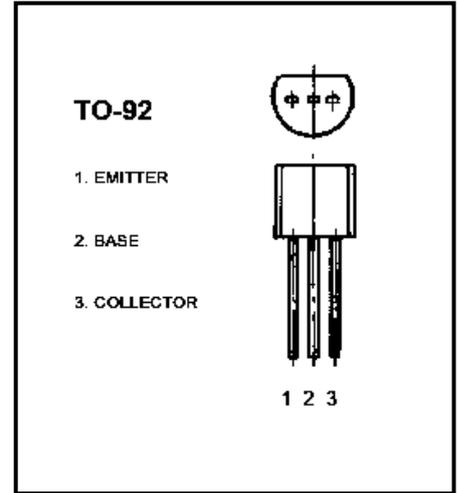
深圳市晶泰源电子有限公司

MPSA94 PNP 晶体管

1、封装形式：TO-92

2、极限参数(绝对最大额定值 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数值	单位
集电极-基极电压	BV_{CBO}	-400	V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	-400	V
发射极-基极电压	BV_{EBO}	-6	V
集电极最大电流	I_{CM}	-300	mA
耗散功率	P_D	625	mW
贮存结温	T_J, T_{STG}	-55~+150	$^{\circ}\text{C}$



3、电参数特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-基极电压	BV_{CBO}	$I_C=-100\mu\text{A}, I_E=0$	-400			V
集电极-发射极电压	BV_{CEO}	$I_C=-1\text{mA}, I_B=0$	-400			V
发射极-基极电压	BV_{EBO}	$I_E=-10\mu\text{A}, I_C=0$	-6			V
集电极-基极漏电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-300\text{V}, I_E=0$			-0.1	μA
集电极-发射极漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=-400\text{V}, I_B=0$			-1	μA
发射极-基极漏电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-6\text{V}, I_C=0$			-0.1	μA
直流放大倍数	H_{FE1}	$V_{CE}=-10\text{V}, I_B=-1\text{mA}$	40			
	H_{FE2}	$V_{CE}=-10\text{V}, I_B=-10\text{mA}$	50		300	
	H_{FE3}	$V_{CE}=-10\text{V}, I_B=-50\text{mA}$	45			
饱和压降	V_{CESAT1}	$I_C=-10\text{mA}, I_B=-1\text{mA}$			-0.2	V
	V_{CESAT2}	$I_C=-50\text{mA}, I_B=-5\text{mA}$			0.3	V
正向压降	V_{BESAT}	$I_C=-10\text{mA}, I_B=-1\text{mA}$			-0.75	V